

IS41C16256

IS41LV16256

ISSI®

2000年6月

256K x 16 (4-MBIT) 动态RAM 用EDO页面模式

特征

- TTL兼容输入和输出
- 刷新间隔: 512个周期/8毫秒
- 刷新模式: RAS-Only, CAS-before-RAS (CBR) 和隐藏
- JEDEC标准引脚
- 单电源
 - 5V±10% (IS41C16256)
 - 3.3V±10% (IS41LV16256)
- 通过两个字节写和字节读操作
- 扩展温度范围-30 °C至85 °C
- 工业温度范围-40 °C至85 °C

描述

该 ISSI IS41C16256和IS41LV16256是262,144 x 16位高performanceCMOSDynamicRandomAccessMemory. 都产品提供加速循环访问EDO页面模式. EDO页面模式允许在一行内进行512次随机访问访问周期时间短至每16位字10ns. 字节写入控制高低字节, 使IS41C16256和IS41LV16256idealforusein16and32-bitwidedatabussystems.

理想情况下, 这些特性使IS41C16256和IS41LV16256成为可能适用于高带宽图形, 数字信号处理, 高性能计算系统和外设应用.

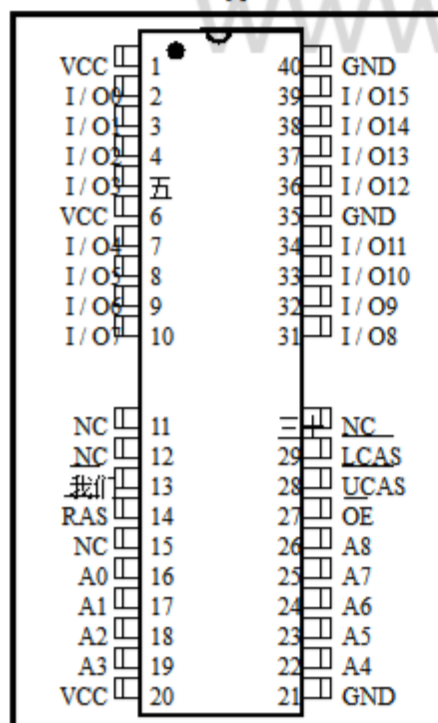
IS41C16256和IS41LV16256采用40引脚封装400密耳SOJ和TSOP (II型).

关键时间参数

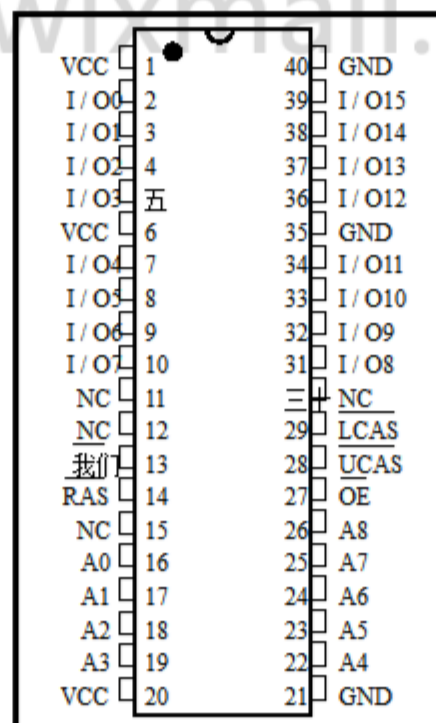
参数	-35	-50	-60	单元
最大. RAS访问时间 (t _{RAC})	3 5 5 0		为 6 0 n s	
最大. CAS访问时间 (t _{CAC})	1 0 1 4		为 1 5 n s	
最大. 列地址访问时间 (t _{AA})	1 8 2 5		为 3 0 n s	
闭. EDO页面模式循环时间 (t _{PC})	1 2 2 0		为 2 5 n s	
闭. 读/写周期时间 (t _{RC})	60	90	110	NS

引脚配置

40引脚TSOP (Type II)



40引脚SOJ

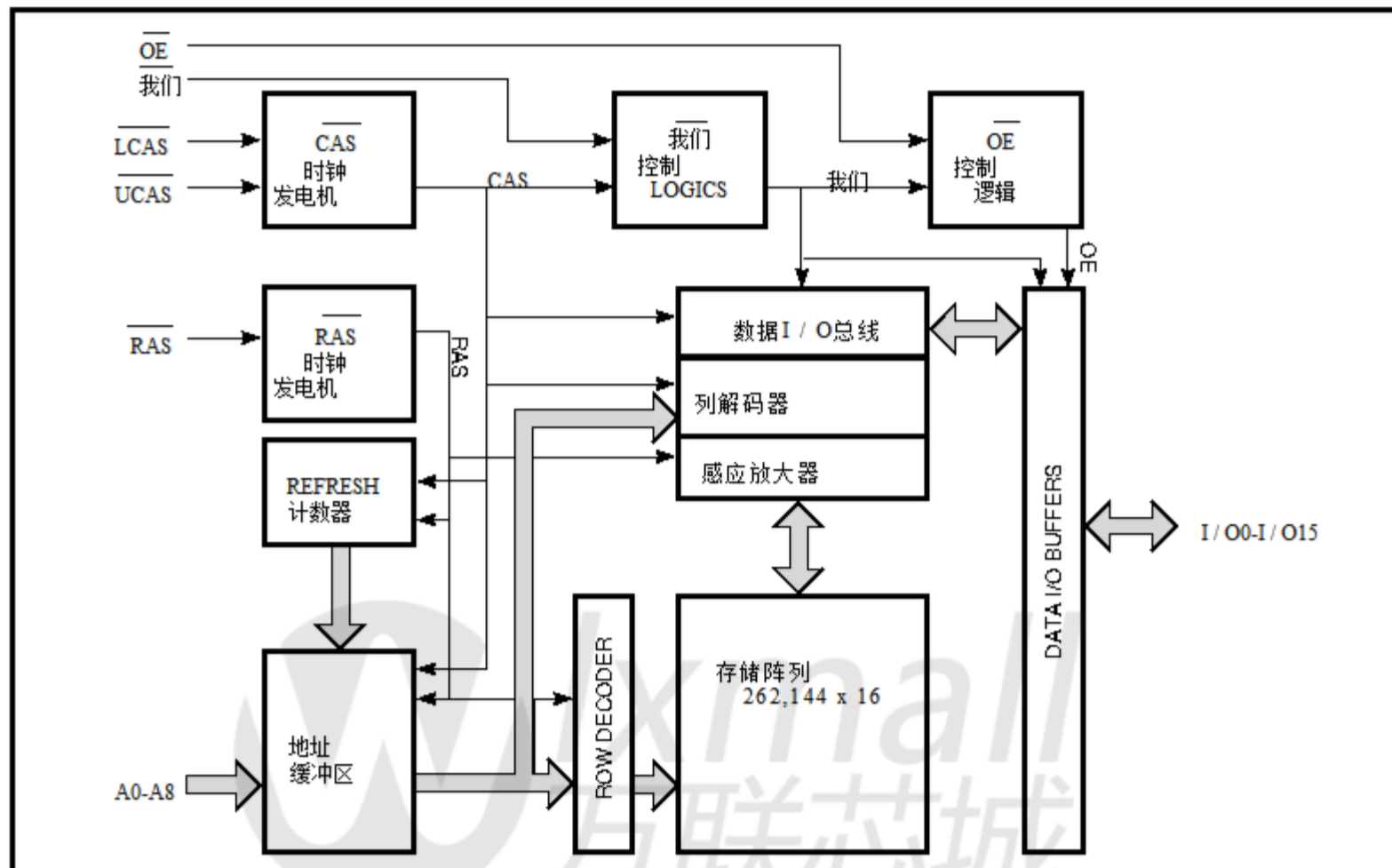


引脚说明

A0-A8	地址输入
I/O0-15	数据输入/输出
我们	写入启用
OE	输出启用
RAS	行地址选通
UCAS	上列地址选通
LCAS	低列地址选通
VCC	功率
GND	地面
NC	无连接

ISSI保留随时更改产品的权利, 恕不另行通知, 以改进设计并提供最佳产品. 我们不承担任何责任
本出版物中可能出现的错误. ©版权所有2000, Integrated Silicon Solution, Inc.

功能框图



真理表

功能	RAS	LCAS	UCAS	我们	OE	地址tR/tC	I/O
支持	H	H	H	X	X	X	高-Z
阅读：字	大号	大号	大号	H	大号	ROW / COL	D OUT
阅读：低字节	大号	大号	H	H	大号	ROW / COL	低字节，D OUT 高字节，高字节
阅读：上字节	大号	H	大号	H	大号	ROW / COL	低字节，高Z 高字节，D OUT
写：单词（早写）	大号	大号	大号	大号	X	ROW / COL	D IN
写：低字节（早写）	大号	大号	H	大号	X	ROW / COL	低字节，D IN 高字节，高字节
写：高字节（早写）	大号	H	大号	大号	X	ROW / COL	低字节，高Z 高字节，D IN
读写（1,2）	二		大号	H→LL→H		ROW / COL	D OUT，D IN
EDO页面模式读取（2）第一次循环：	大号	H→LH→L		H	大号	ROW / COL	D OUT
第二周期：	大号	H→LH→L		H	大号	NA / COL	D OUT
任何周期：	大号	H→HL→H		H	大号	NA / NA	D OUT
EDO页面模式写入（1）第一次循环：	大号	H→LH→L		大号	X	ROW / COL	D IN
第二周期：	大号	H→LH→L		大号	X	NA / COL	D IN
EDO页面模式读写（1,2）第一周期：	大号	H→LH→LH→LL→H				ROW / COL	D OUT，D IN
第二周期：	大号	H→LH→LH→LL→H				NA / COL	D OUT，D IN
隐藏刷新 2）阅读L	→H→L	大号	大号	H	大号	ROW / COL	D OUT
写L	→H→L	大号	大号	大号	X	ROW / COL	D OUT
仅RAS刷新	大号	H	H	X	X	ROW / NA	高-Z
CBR刷新（3）	H→L	大号	大号	X	X	X	高-Z

笔记：

1. 这些写周期也可以是字节写周期（或者是 LCAS或UCAS有效）。
2. 这些读周期也可以是字节读周期（或者是 LCAS或UCAS有效）。
3. 至少有一个 CAS信号必须处于活动状态（LCAS或UCAS）。

功能说明

IS41C16256和IS41LV16256是一款CMOS DRAM
针对高速带宽，低功耗应用进行了优化，
蒸发散。在读或写周期期间，每一位都是唯一的
通过18个地址位进行寻址。这些是en-
每次测试9位（A0-A8）。行地址是
由行地址选通锁存（RAS）。该列
地址由列地址选通锁存（CAS）。
RAS用于锁存前九位，并使用CAS
后九位。

IS41C16256和IS41LV16256有两个CAS控制
tcols，LCAS和UCAS。LCAS和UCAS输入
内部生成一个CAS信号在标识符中运行，
以单一的方式CAS输入另一个256K x
16个DRAM。关键的区别是每个CAS控制
其相应的I/O三态逻辑（与OE
和我们和RAS）。LCAS通过I/O7和I/O0控制I/O0
UCAS通过I/O15控制I/O8。

IS41C16256和IS41LV16256CAS功能是
由第一个决定CAS（LCAS或UCAS）过渡
LOW并且最后一次转变回HIGH。他们俩CAS
控制给予IS41C16256 BYTE READ和
BYTE WRITE循环功能。

记忆周期

一个存储周期是由带来的RAS低，它是
通过返回而终止RAS和CAS高。至
确保正确的设备操作和数据完整性
记忆周期一旦启动，就不能结束或
在最小tRAS时间到期之前中止。一个新的
在最小预充电之前不能启动循环
时间tRP，tCP已经过去。

读周期

读周期由下降沿启动CAS或OE，
以最后发生者为准，同时持有我们很高兴。该
列地址必须保持最短时间speci-
由tAR联系。数据输出仅在tRAC，tAA，
tCAC和tOEA都满意。因此，访问时间
取决于这些之间的时序关系
参数。

写周期

写周期由下降沿启动CAS和
我们，以最后发生者为准。输入数据必须有效
在...之前或之后CAS或WE，无论哪一个
最后发生。

刷新周期

要保留数据，每个都需要512个刷新周期
8毫秒周期。有两种方法可以刷新内存。

- 1.通过对512个行地址中的每一个进行计时（A0到A0）
A8）与RAS至少每8毫秒一次。任何阅读，写作，
读 - 修改 - 写或仅RAS循环刷新ad-
打扮的行。
- 2.使用一个CAS-before-RAS刷新周期。CAS-在一
RAS刷新由RAS的下降沿激活，
同时举行CAS LOW。在CAS-before-RAS刷新
周期，内部9位计数器提供行ad-
礼服和外部地址输入被忽略。

CAS-before-RAS是仅更新模式，没有数据
访问或设备选择是允许的。因此，输出
在周期中保持高Z状态。

扩展数据输出页面模式

EDO页面模式操作允许其中的所有512列
一个选定的行以高数据随机访问
率。

在EDO页面模式读取周期中，数据输出保持为
下一个CAS周期的下降沿，而不是上升沿。
出于这个原因，EDO页面中的有效数据输出时间
模式与快速页面模式相比得到扩展。在
快速页面模式，有效数据输出时间变成
比较短CAS循环时间变短。那里-
因此，在EDO页面模式下，读周期中的时序余量
比快速页面模式的大，即使是CAS
周期时间变短。

在EDO页面模式下，由于扩展数据功能，
CAS循环时间可以比在快速页面模式下更短
如果时间裕度相同。

EDO页面模式允许读取和写入操作 -
tions期间RAS周期，但表现是
相当于那种情况下的快速页面模式。

打开

应用VCC电源后，最初暂停
需要200μs，然后至少8个初始 -
循环（包含a的循环的任意组合）
RAS信号）。

在开机过程中，建议这样做RAS跟踪
VCC或保持在有效的VIH以避免电涌。

绝对最大额定值 (1)

符号	参数	评分		单元
V T	任何引脚相对于GND的电压	5V	-1.0至+7.0	V
		3.3V	-0.5至4.6	V
V CC	电源电压	5V	-1.0至+7.0	V
		3.3V	-0.5至4.6	V
我 OUT	输出电流	50		嘛
P.D.	功耗	1		w ^
T A.	商业操作温度	0到+70		C
	扩展温度	-30到+85		C
	工业温度	-40到+85		C
T STG	储存温度	-55到+125		C

注意:

- 1.大于绝对最大额定值下所列的应力可能会导致永久性设备损坏.这只是压力等级和设备在这些功能操作或高于本规范操作部分所述条件的任何其他条件不适用默示.长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会受到影响可靠性.

建议的工作条件 (电压以GND为基准.)

符号	参数	阈.	典型.	最大.	单元	
V CC	电源电压	5V	4.5	5	5.5	V
		3.3V	3.0	3.3	3.6	
V IH	输入高电压	5V	2.4	-	V CC + 1.0	V
		3.3V	2.0	-	V CC + 0.3	
V IL	输入低电压	5V	-1.0	-	0.8	V
		3.3V	-0.3	-	0.8	
T A.	商业环境温度	0	-	70	C	
	扩展的环境温度	-30	-	85	C	
	工业环境温度	-40	-	85	C	

电容 (1,2)

符号	参数	最大.	单元
C IN1	输入电容: A0-A8	五	pF的
C IN2	输入电容: RAS, UCAS, LCAS, WE, OE	7 p F 的	
C IO	数据输入/输出电容: I / O0-I / O15	7	pF的

笔记:

- 1.最初和经过可能影响这些参数的任何设计或工艺更改后进行测试.
- 2.测试条件: T A = 25°C, f = 1MHz,

电气特性 (1)

(除非另有说明, 建议的操作条件)

符号参数	测试条件	速度	闲.	最大.	单元
我 IL	输入漏电流 任何输入 0V $\leq V_{IN} \leq V_{CC}$ 其他未经测试的输入 = 0V		-10	10	μA
我 IO	输出泄漏电流 输出被禁用 (Hi-Z) 0V $\leq V_{OUT} \leq V_{CC}$		-10	10	μA
V OH	输出高电平 I OH = -2.5mA		2.4	-	V
V OL	输出低电平 I OL = +2.1mA		-	0.4	V
我 CC 1	待机电流: TTL RAS, LCAS, UCAS $\geq V_{IH}$ 商用5V 产业 广告 产业	5V 3V 3V	- - -	3 4 2 3	毫 安
我 CC 2	待机电流: CMOS RAS, LCAS, UCAS $\geq V_{CC} - 0.2V$	5V 3V	- -	2 1	毫 安
我 CC 3	工作电流: 随机读取/写入 (2,3,4) 平均电源电流 RAS, LCAS, UCAS, 地址自行车, t RC = t RC (min.)	-35 -50 -60	- - -	230 180 170	嘛
我 CC 4	工作电流: EDO页面模式 (2,3,4) 平均电源电流 RAS = V IL, LCAS, UCAS, 循环 t PC = t PC (min.)	-35 -50 -60	- - -	220 170 160	嘛
我 CC 5	刷新当前: 仅限RAS (2,3) 平均电源电流 RAS自行车, LCAS, UCAS $\geq V_{IH}$ t RC = t RC (min.)	-35 -50 -60	- - -	230 180 170	嘛
我 CC 6	刷新当前: CBR (2,3,5) 平均电源电流 RAS, LCAS, UCAS单车 t RC = t RC (min.)	-35 -50 -60	- - -	230 180 170	嘛

笔记:

- 上电8次后需要200 μs 的初始暂停
操作是有保证的. 八个
任何时候 超过 t REF 刷新要求都应该重复RAS周期唤醒 .
- 取决于循环速率.
- 使用最小循环时间和输出打开来获得指定值.
- 每个EDO页面周期一次更改列地址.
- 启用片上刷新和地址计数器.

交流特性 (1,2,3,4,5,6)

(除非另有说明, 建议的操作条件.)

符号	参数	-35		-50		-60		单位
		阅.	最大.	阅.	马克斯	阅.	最大.	
t RC	随机读取或写入循环时间	60	-	90	-	110	-	NS
t RAC	访问时间从 RAS (6,7)	35	-	50	-	60	NS	
t CAC	访问时间从 CAS (6,8,15)	-	10	-	14	-	15	NS
t AA	从列地址访问时间 (6)	-	18	-	25	-	三十	NS
RAS	RAS脉冲宽度	35	10 K	50	10 K	60	10 K	NS
t RP	RAS预充电时间	20	-	三十	-	40	-	NS
t CAS	CAS脉冲宽度 (26)	6	10K	8	10K	10	10K	NS
t CP	CAS预充电时间 (9,25)	五	-	8	-	10	-	NS
t CSH	CAS保持时间 (21)	35	-	50	-	60	-	NS
t RCD	RAS到CAS延迟时间 (10,20)	11	28	19	36	20	45	NS
t ASR	行地址建立时间	0	-	0	-	0	-	NS
t RAH	行地址保持时间	6	-	8	-	10	-	NS
t ASC	列地址建立时间 (20)	0	-	0	-	0	-	NS
CAH	列地址保持时间 (20)	6	-	8	-	10	-	NS
t AR	列地址保持时间 (参考 RAS)	三十	-	40	-	40	-	NS
T RAD	RAS到列地址延迟时间 (11)	10	20	14	25	15	三十	NS
t RAL	列地址 RAS提前期	18	-	25	-	三十	-	NS
RPC	RAS到CAS预充电时间	0	-	0	-	0	-	NS
t RSH	RAS保持时间 (27)	8	-	14	-	15	-	NS
t CLZ	CAS以低Z输出 (15,29)	3	-	3	-	3	-	NS
t CRP	CAS到RAS预充电时间 (21)	五	-	五	-	五	-	NS
t OD	输出禁用时间 (19,28,29)	3 1 2		3	12	3 1 2		NS
t OE/t OEA	输出使能时间 (15,16)	0 1 0		0	15	-	15	NS
t OEHC	OE HIGH保持时间从CAS高	10	-	10	-	10	-	NS
OEP	OE高脉冲宽度	10	-	10	-	10	-	NS
OES	OE低到CAS高建立时间	五	-	五	-	五	-	NS
t RCS	读命令设置时间 (17, 20)	0	-	0	-	0	-	NS
t RRH	读命令保持时间 (参考 RAS) (12)	0	-	0	-	0	-	NS
t RCH	读命令保持时间 (参考 CAS) (12,17,21)	0	-	0	-	0	-	NS
t WCH	写命令保持时间 (17,27)	五	-	8	-	10	-	NS
t WCR	写命令保持时间 (参考 RAS) (17)	三十	-	40	-	50	-	NS

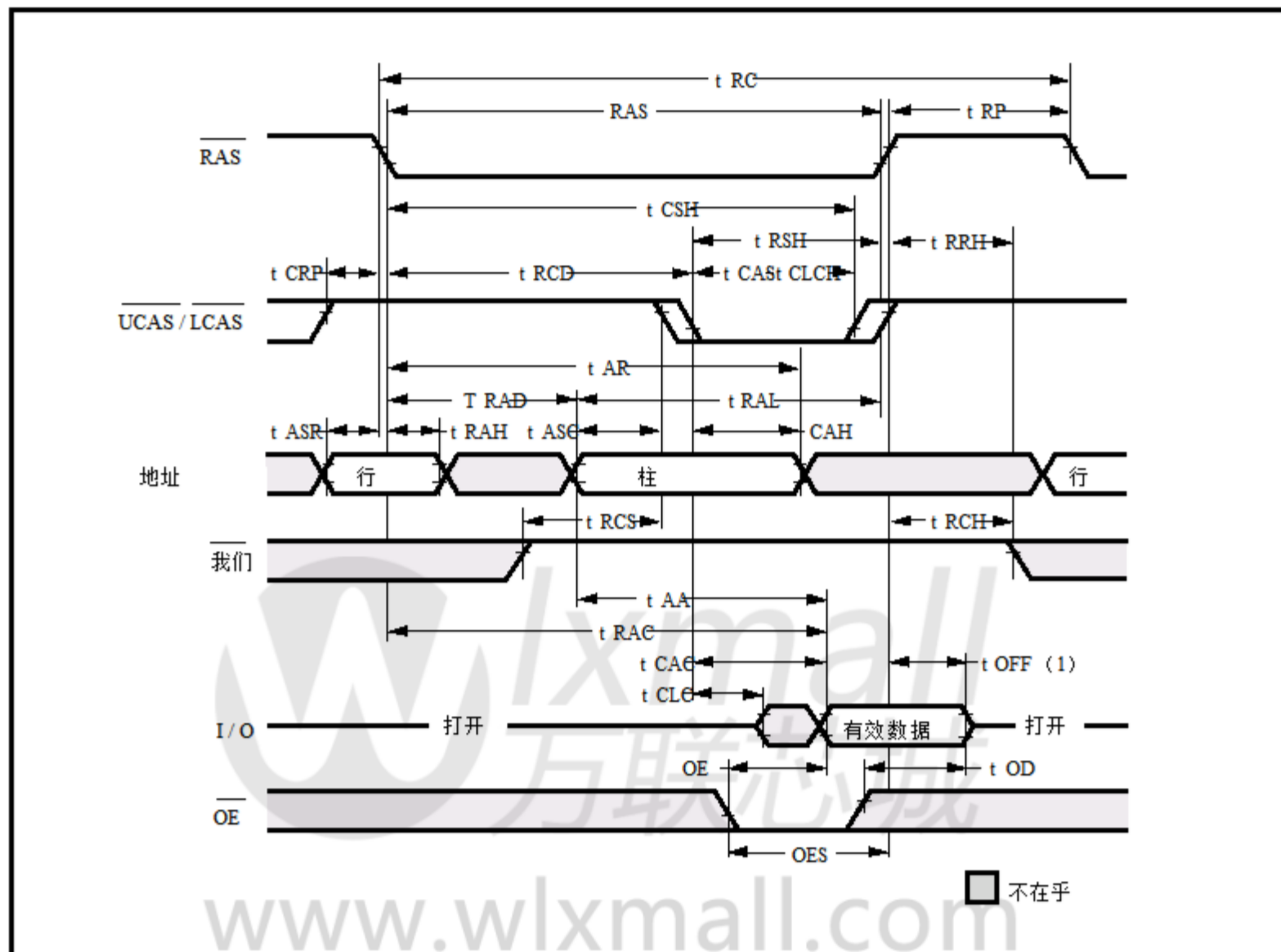
交流特性 (续) (1,2,3,4,5,6)
(除非另有说明, 建议的操作条件.)

符号	参数	-35		-50		-60		单位
		闭.	最大.	闭.	最大.	闭.	最大.	
t WP	写命令脉冲宽度 (17)	五	-	8	-	10	-	NS
t WPZ	我们脉宽禁用输出	10	-	10	-	10	-	NS
t RWL	将命令写入 RAS提前期 (17)	8	-	14	-	15	-	NS
t CWL	将命令写入 CAS提前期 (17,21)	8	-	14	-	15	-	NS
t WCS	写命令建立时间 (14, 17, 20)	0	-	0	-	0	-	NS
DHR	数据保持时间 (参考 RAS) 30	-	-	40	-	40	-	NS
t ACH	列地址建立时间到 CAS	15	-	15	-	15	-	NS
t OEH	OE在WE期间保持我们的时间 READ-MODIFY-WRITE周期 (18)	8	-	8	-	15	-	NS
t DS	建立时间数据 (15,22)	0	-	0	-	0	-	NS
卫生署	数据保持时间 (15,22)	6	-	6	-	10	-	NS
t RWC	READ-MODIFY-WRITE循环时间	80	-	100	-	140	-	NS
t RWD	RAS到我们延迟的时间 READ-MODIFY-WRITE周期 (14)	45	-	50	-	80	-	NS
t CWD	CAS到我们延迟时间 (14,20)	25	-	三十	-	36	-	NS
t AWD	列地址 我们延迟时间 (14)	三十	-	三十	-	49	-	NS
t PC	EDO页面模式READ或WRITE 周期时间 (24)	12	-	15	-	25	-	NS
t RASP	EDO页面模式下的RAS脉冲宽度	35	100K	40	100K	60	100K	NS
t CPA	访问时间从 CAS预充电 (15)	-	21	-	27	-	34	NS
t PRWC	EDO页面模式READ-WRITE 周期时间 (24)	40	-	45	56	-	NS	
t COH / t DOH	数据输出后保持 CAS LOW	五	-	五	-	五	-	NS
关闭	输出缓冲器关闭延迟从 CAS或RAS (13,15,19,29)	3	15	3	15	3	15	NS
吨 WHZ	输出禁止延迟 我们	3	15	3	15	3	15	NS
t CLCH	持续 CAS将低至第一个CAS 返回高 (23)	10	-	10	-	10	-	NS
t CSR	CAS建立时间 (CBR REFRESH) (30,20)	8	-	10	-	10	-	NS
t CHR	CAS保持时间 (CBR REFRESH) (30,21)	8	-	10	-	10	-	NS
t ORD	在RAS之前的OE安装时间 隐藏刷新周期	0	-	0	-	0	-	NS
t REF	刷新周期 (512个周期)	-	8	-	8	-	8 m s	的
t T	转换时间 (上升或下降) (2, 3)	1	50	1	50	1	50	NS

笔记:

1. 上电8次后需要200 μ s的初始暂停
操作是有保证的. 八个 任何时候 超过 t_{REF} 刷新要求都 应该重复RAS周期唤醒.
2. V_{IH} (MIN) 和 V_{IL} (MAX) 是测量输入信号时序的参考电平. 过渡时间, 在 V_{IH} 之间测量
和 V_{IL} (或 V_{IL} 和 V_{IH} 之间), 并假设所有输入均为1 ns.
3. 除满足转换速率规范外, 所有输入信号必须在 V_{IH} 和 V_{IL} (或 V_{IL} 和 V_{IH} 之间) 之间 传输
单调的方式.
4. 如果 AS 和 $RAS = V_{IH}$, 数据输出为高阻态.
5. 如果 $AS = V_{IL}$, 数据输出可能包含来自上一个有效读周期的数据.
6. 用相当于一个TTL门和50 pF的负载进行测量.
7. 假设 $t_{RCD} - t_{RCD} (MAX)$. 如果 t_{RCD} 大于此表中所示的最大推荐值, t_{RAC} 将增加
 t_{RCD} 超出所示值的数量.
8. 假设 $t_{RCD} \cdot t_{RCD} (MAX)$.
9. 如果 AS 在 RAS 的下降沿处为低电平, 数据输出将从前一周期保持. 启动一个新的循环并清除
数据输出缓冲区, CAS 和 RAS 必须脉冲 t_{CP} .
10. 使用 $t_{RCD} (MAX)$ 限制的操作可确保达到 $t_{RAC} (MAX)$. $t_{RCD} (MAX)$ 仅被指定为参考点; 如果 t_{RCD}
大于指定的 $t_{RCD} (MAX)$ 限制, 存取时间仅由 t_{CAC} 控制.
11. 在 $RAD (MAX)$ 极限内的操作 确保可以满足 $t_{RCD} (MAX)$. $t_{RAD} (MAX)$ 仅被指定为参考点; 如果 T_{RAD}
大于指定的 $t_{RAD} (MAX)$ 限制, 存取时间仅由 t_{AA} 控制.
12. READ循环必须满足 t_{RCH} 或 t_{RRH} .
13. $t_{OFF} (MAX)$ 定义输出达到开路条件的时间; 它不是对 V_{OH} 或 V_{OL} 的提及.
- t_{WCS} , t_{RWD} , t_{AWD} 和 t_{CWD} 仅限于LATE WRITE和READ-MODIFY-WRITE周期的限制性工作参数. 如果 $t_{WCS} \cdot$
 $t_{WCS} (MIN)$ 时, 该周期是一个早期写周期, 整个周期内数据输出将保持开路. 如果 $t_{RWD} \cdot$
 $t_{RWD} (MIN)$, $t_{AWD} \cdot t_{AWD} (MIN)$ 和 $t_{CWD} \cdot t_{CWD} (MIN)$, 周期为读写周期, 数据输出将包含数据读取
从选定的单元格. 如果上述条件都不满足, 则 I/O 的状态 (在访问时和直到 CAS 和 RAS 或 OE 去
回到 V_{IH}) 是不确定的. OE 保持高电平, 并且在 CAS 变为低电平后我们变为低电平, 导致LATE WRITE (OE 控制)
周期.
15. 输出参数 (I/O) 被引用到相应的 CAS 输入, $LCAS$ 的 $I/O0-I/O7$ 和 $UCAS$ 的 $I/O8-I/O15$.
16. 在读周期中, 如果 在 CAS 变为高电平之前, OE 变为低电平然后变为高电平, I/O 打开. 如果 OE 永久绑定低, a
- LATE WRITE或READ-MODIFY-WRITE是不可能的.
17. 写入命令被定义为 我们走低.
18. LATE WRITE和READ-MODIFY-WRITE周期必须同时满足 t_{OD} 和 t_{OEH} (OE 高写周期期间) 为了
确保在写周期内输出缓冲器将被打开. I/O 将提供以前写入的数据 CAS
保持低水平 在 OEH 被满足后, OE 被带回LOW.
19. 一旦 t_{OD} 或 t_{OFF} 发生, I/O 在READ周期期间打开.
20. 第一个 χ_{CAS} 边沿转换为低电平.
21. 最后 χ_{CAS} 边沿转换为高电平.
22. 这些参数被引用 CAS 前沿在早期写周期和我们的前沿在晚写或
READ-MODIFY-WRITE周期.
23. 最后下降 χ_{CAS} 优先 χ_{CAS} 边缘上升.
24. 最后上升 χ_{CAS} 沿着下一个周期的最后一个上升 χ_{CAS} 沿.
25. 最后崛起 χ_{CAS} 边缘首先下降 χ_{CAS} 边缘.
26. 每个 χ_{CAS} 必须符合最小脉冲宽度.
27. 最后 χ_{CAS} 将变低.
28. 无论如何控制 I/O $UCAS$ 和 $LCAS$.
29. 最小3 ns是一个由设计保证的参数.
30. 启用片上刷新和地址计数器.

阅读周期

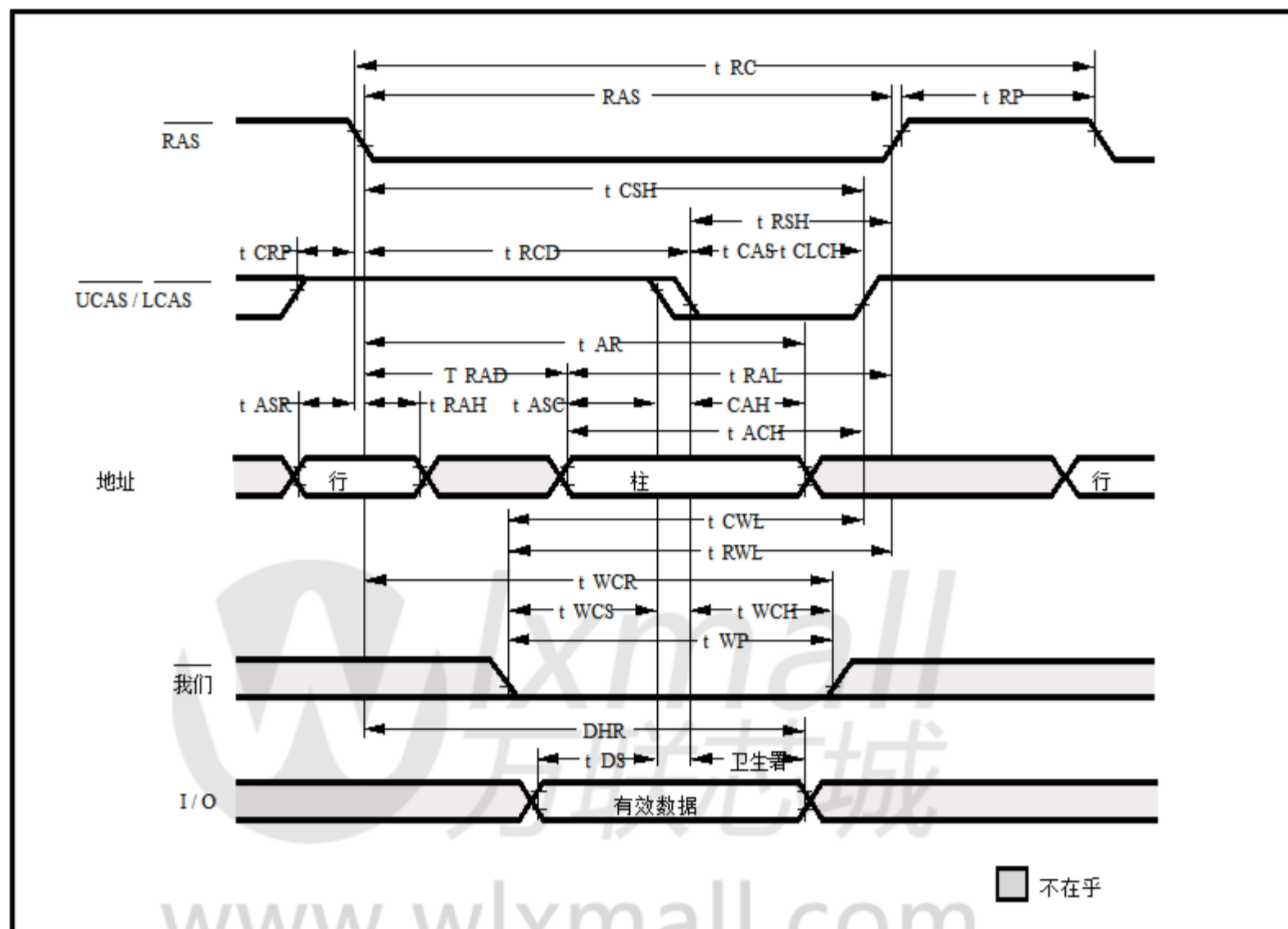


注意:

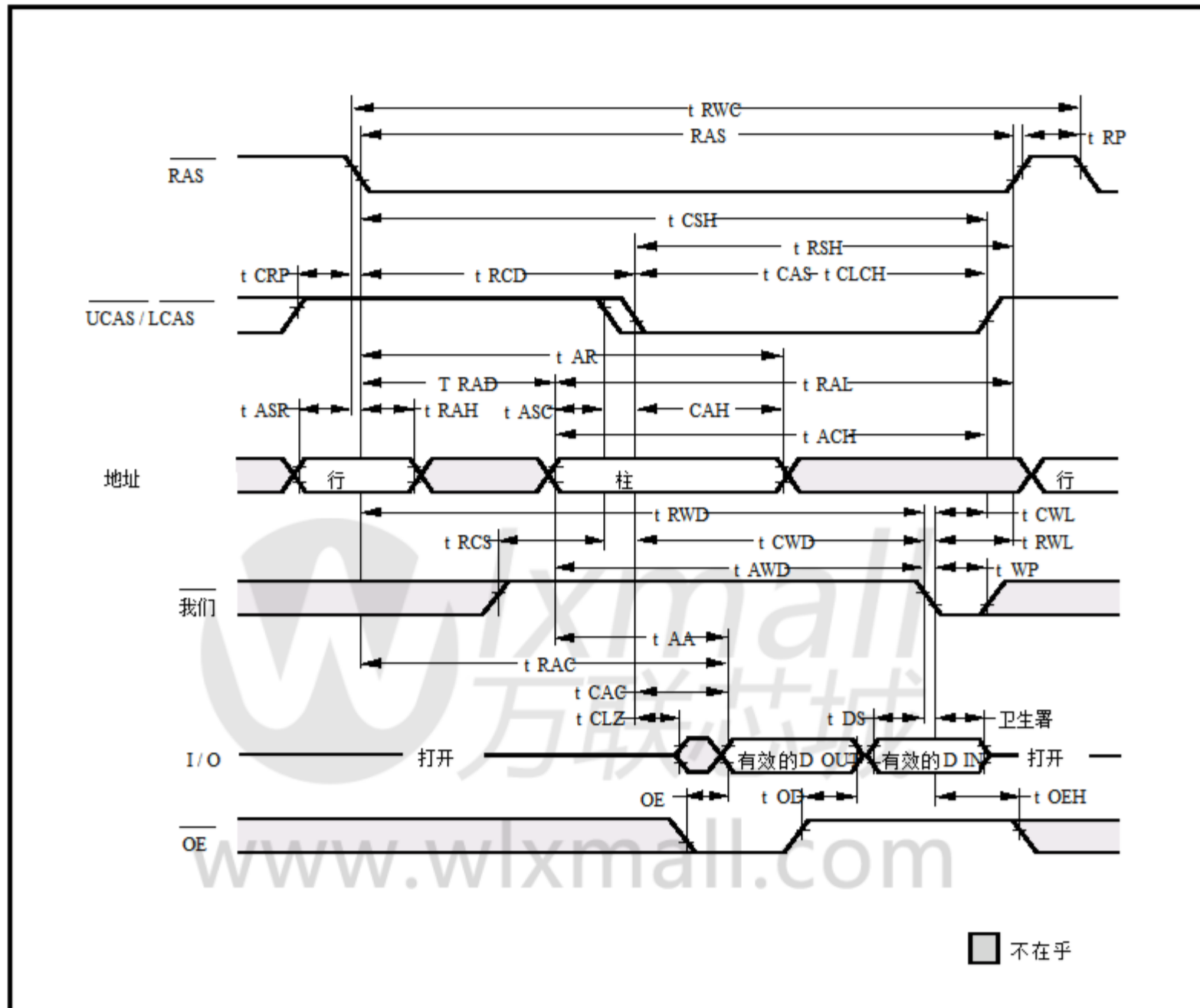
1. t_{OFF} 由上升沿引用

RAS或CAS，以最后发生者为准。

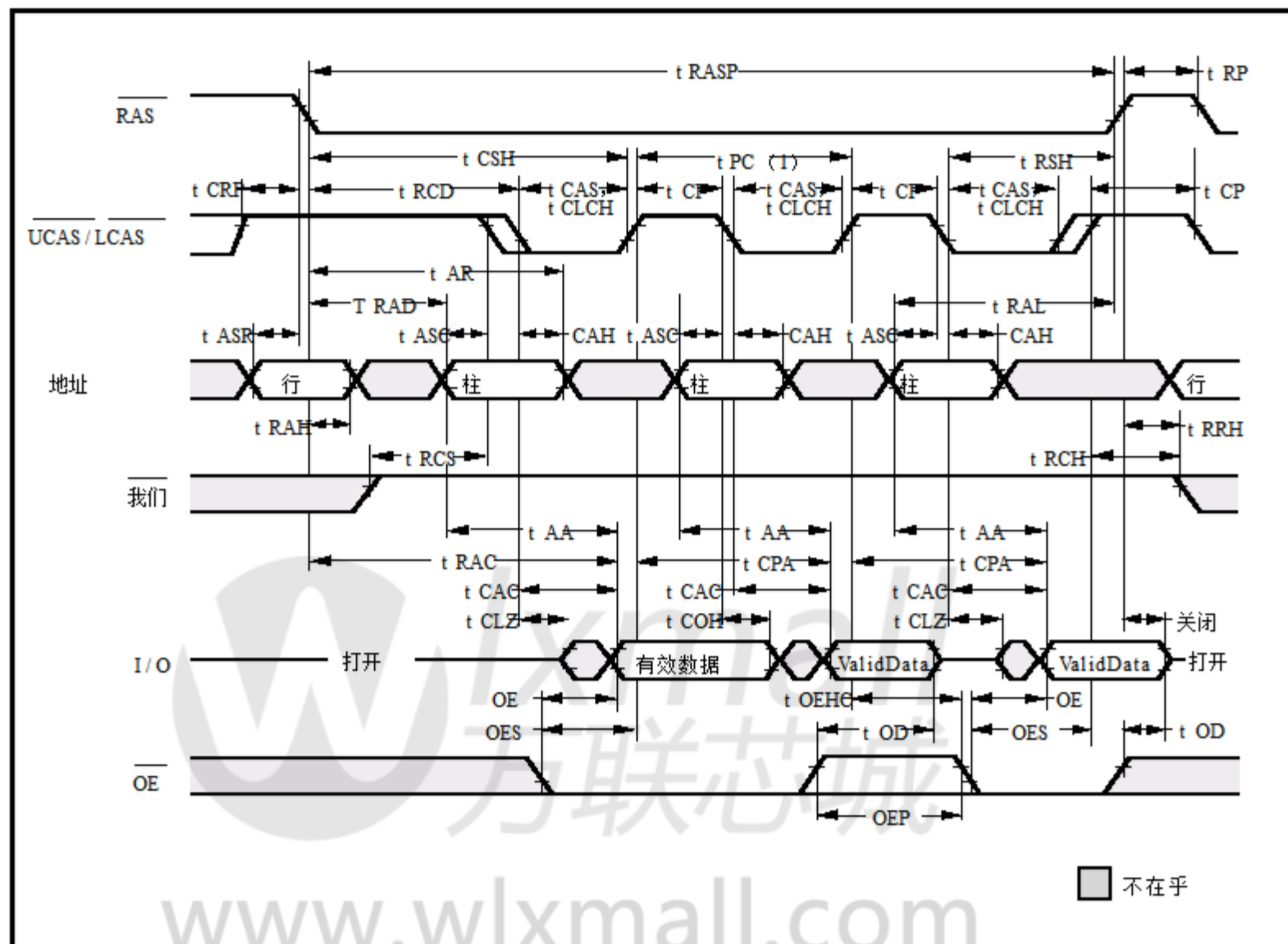
早期写周期 (OE = 不要关心)



读写周期（写后读和修改写周期）



EDO-PAGE-MODE 读取周期

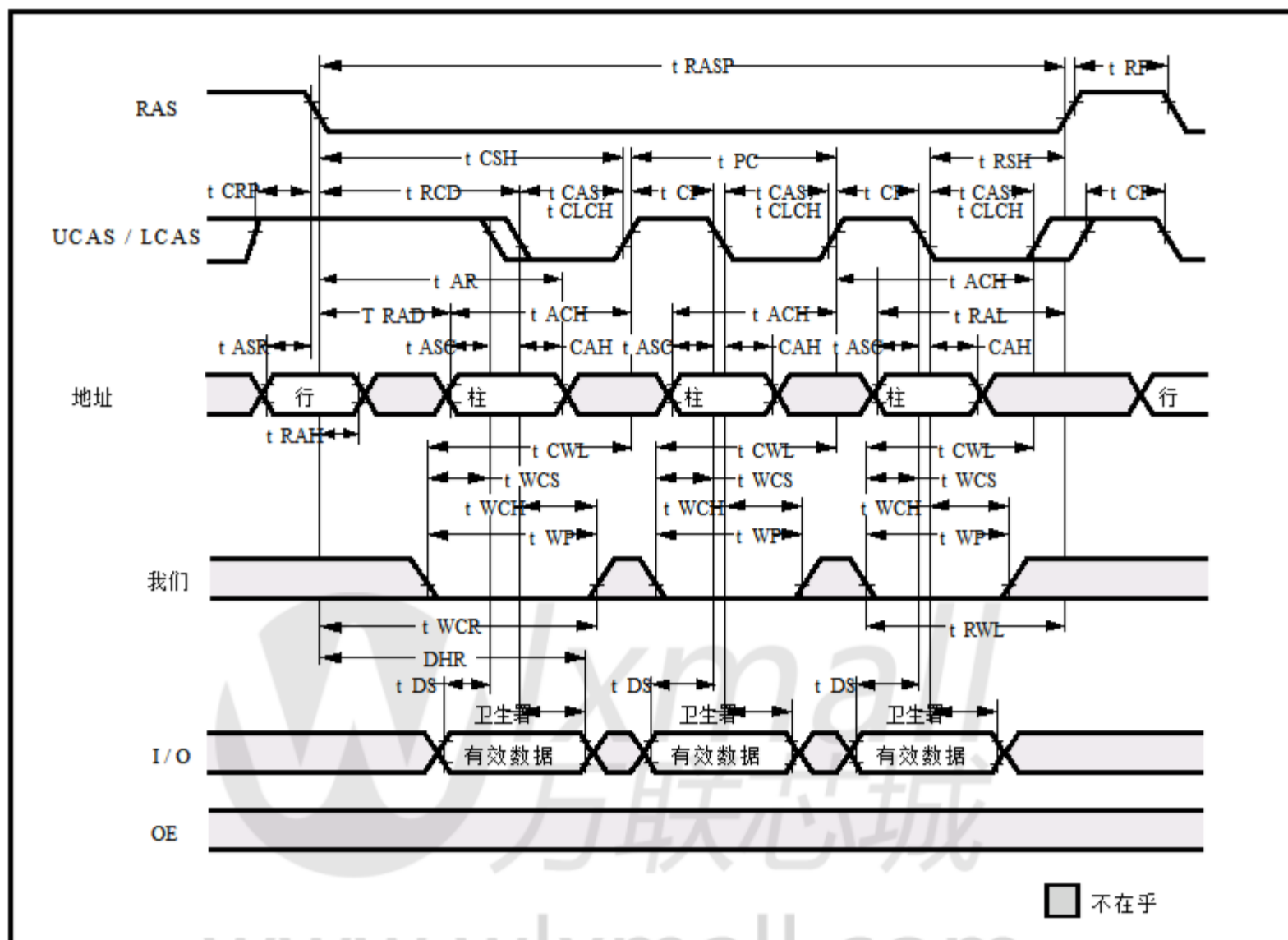


注意:

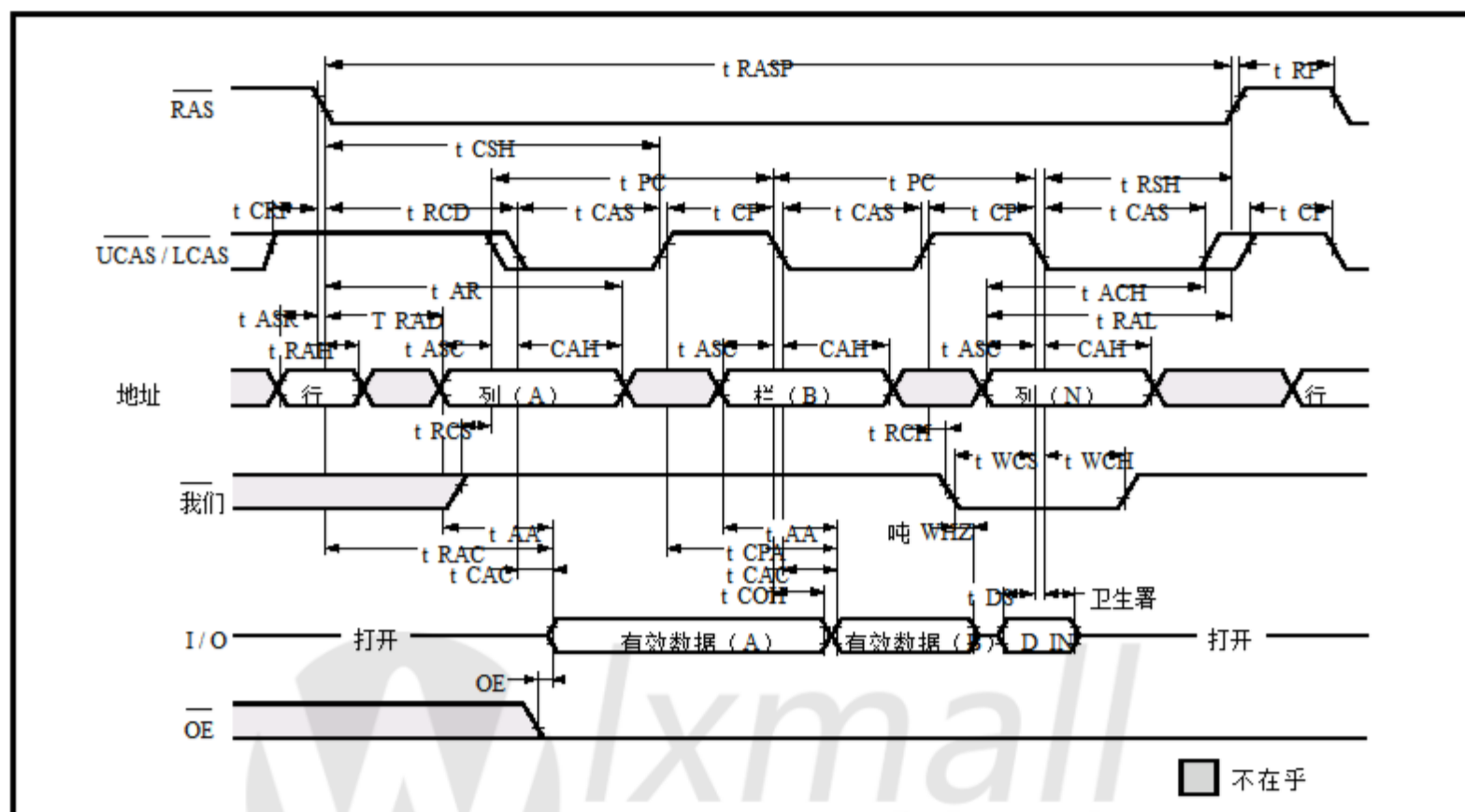
1. 可以从下降沿测量 PC
测量必须符合 t_{PC} 规范.

CAS到CAS的下降沿, 或者从CAS的上升沿到CAS的上升沿.都

EDO-PAGE-MODE预写周期

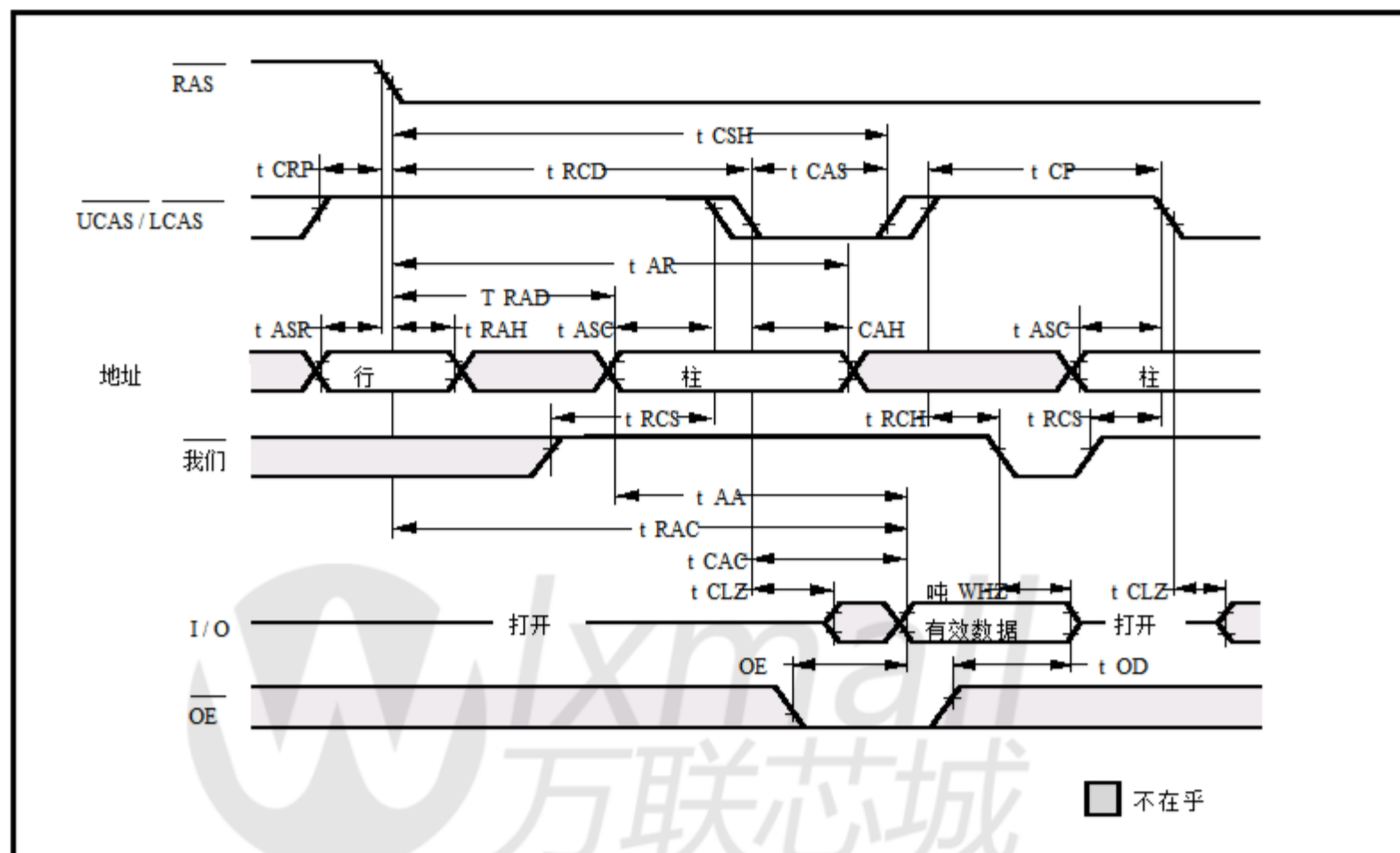


EDO-PAGE-MODE READ-EARLY-WRITE CYCLE (伪读取修改写入)

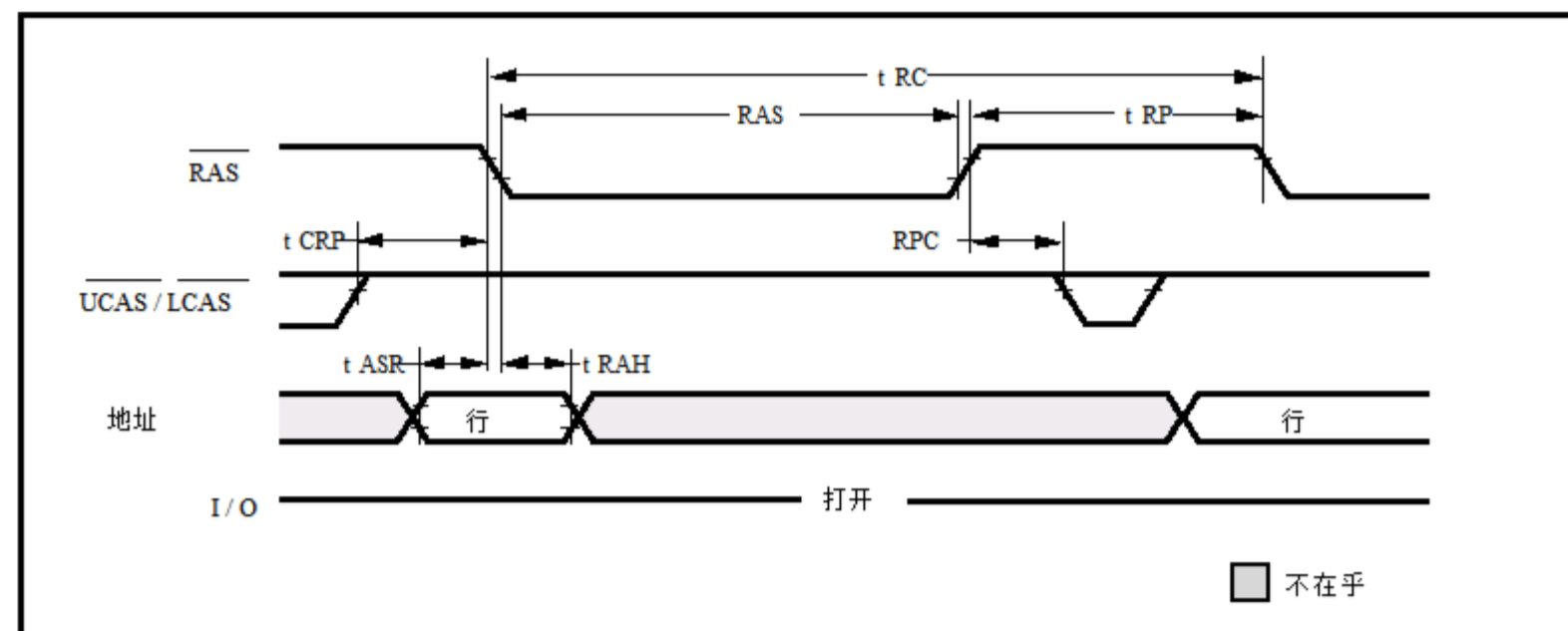


交流波形
读周期（带

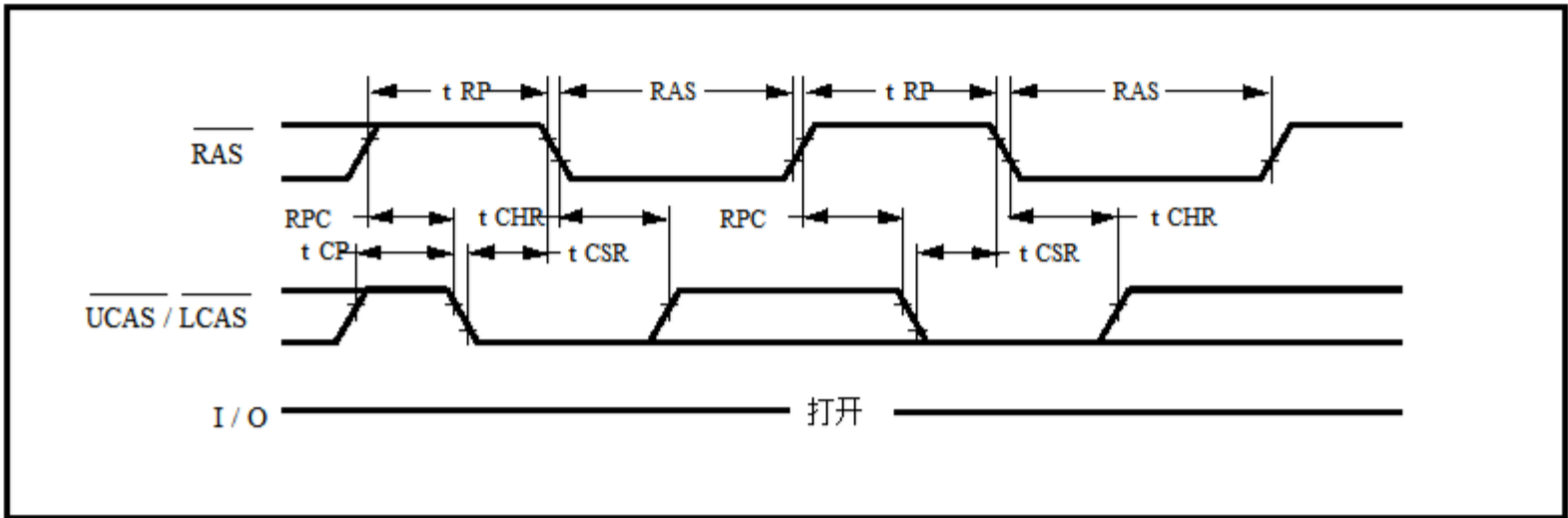
WE-Controlled禁用）



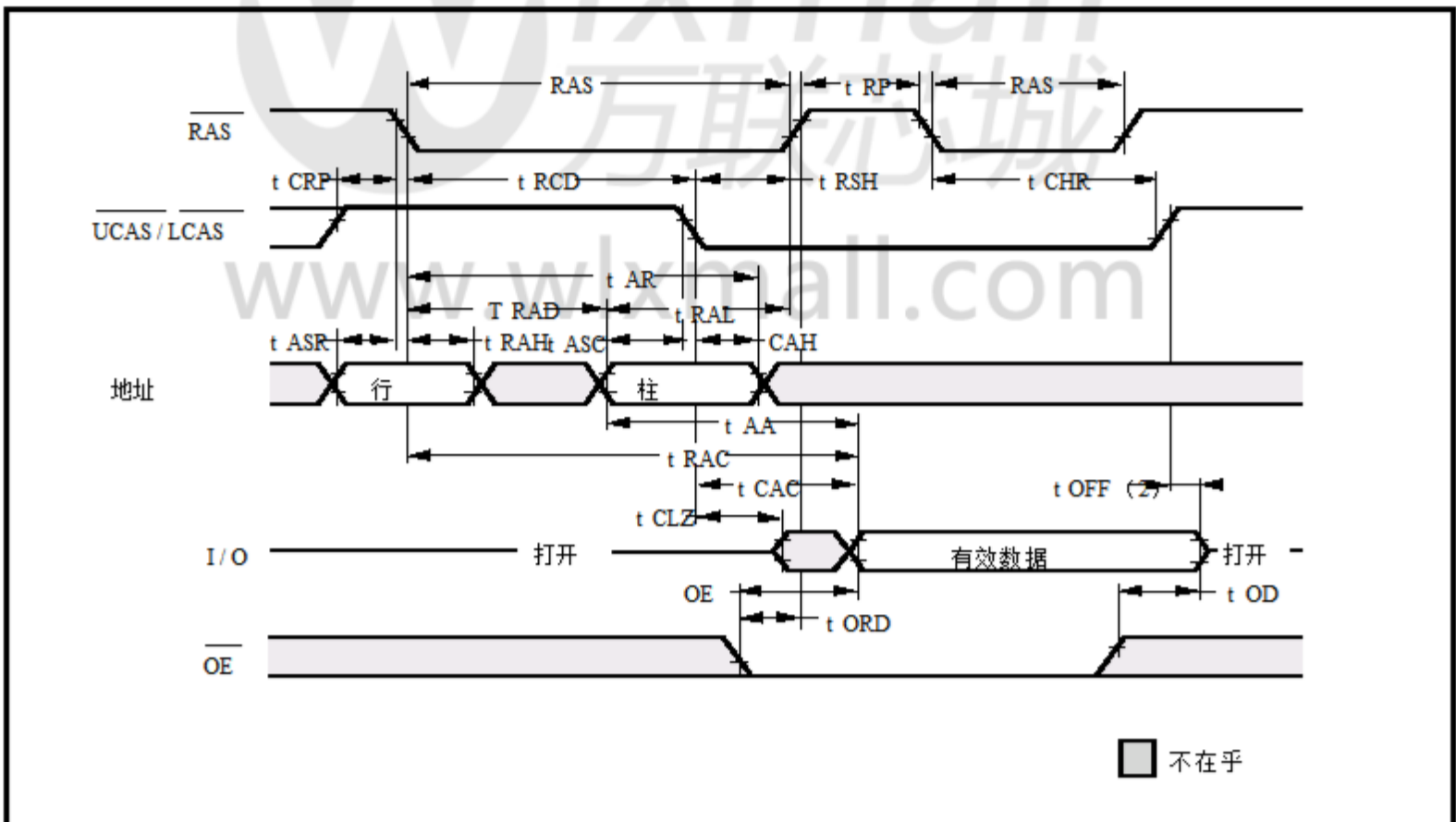
RAS-Only刷新周期（OE，我们=不关心）



CBR REFRESH CYCLE (地址;我们, OE =不关心)



HIDDEN刷新周期 (WE = HIGH; OE = LOW) (1)



笔记:

1. 写入循环后, 也可以执行隐藏刷新. 在这种情况下, RAS或CAS, 以最后发生者为准.
2. t_{OFF} 从上升沿引用

WE = LOW和OE = HIGH.

订购信息: 5V

商业范围: 0 C到70 C

速度 (ns)	订购型号	包
35	IS41C16256-35K	400万密尔SOJ
	IS41C16256-35T	400密耳TSOP (II型)
60	IS41C16256-60K	400万密尔SOJ
	IS41C16256-60T	400密耳TSOP (II型)

订购信息: 3.3V

商业范围: 0 C到70 C

速度 (ns)	订购型号	包
35	IS41LV16256-35K	400万密尔SOJ
	IS41LV16256-35T	400密耳TSOP (II型)
60	IS41LV16256-60K	400万密尔SOJ
	IS41LV16256-60T	400密耳TSOP (II型)

订购信息: 5V

工业范围: -40 Cto85 C

速度 (ns)	订购型号	包
50	IS41C16256-50KI	400万密尔SOJ
	IS41C16256-50TI	400密耳TSOP (II型)
60	IS41C16256-60KI	400万密尔SOJ
	IS41C16256-60TI	400密耳TSOP (II型)

订购信息: 3.3V

工业范围: -40 Cto85 C

速度 (ns)	订购型号	包
60	IS41LV16256-60KI	400万密尔SOJ
	IS41LV16256-60TI	400密耳TSOP (II型)

Wlxmall
万联芯城
www.wlxmall.com